



Э Т И К Е Т К А

Полупроводниковые интегральные микросхемы на полевых транзисторах 504УН1, 504УН2

Основное назначение: Усилитель

Электрическая схема

Порядок расположения выводов

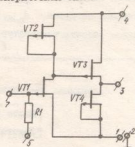
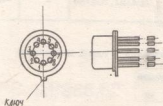
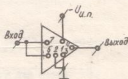


Схема включения



Назначение выводов

Контакт	Цепь
1	2
1, 2	Земля
3	Выход
4	(- / н.п.)
5, 7	Вход

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ ПОСТАВКЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ $25 \pm 10^\circ\text{C}$ И НОМИНАЛЬНОМ НАПРЯЖЕНИИ ПИТАНИЯ

Наименование параметра	Тип (типономинал)	Норма	
		не более	не менее
Коэффициент усиления напряжения, $K_{у,н}$ при $f = 1 \text{ кГц}$, $R_H = \infty$, $U_{н.п.} = -12 \text{ В}$, $U_{вх} = 1 \text{ мВ}$	504УН1А, 504УН2А	60	20
	504УН1Б, 504УН2Б	120	40
	504УН1В, 504УН2В	200	80
Ток потребления, при $U_{н.п.} = -12 \text{ В}$, $I_{пот}$ $U_{вх} = 0$, $R_H = \infty$ мА	504УН1	5	-
	504УН2	-	-
Напряжение шумов, приведенное к входу при $f = 5 \cdot 10^4 \text{ Гц}$, $U_{ш,вх}$ $R_T = 0$, $U_{н.п.} = -12 \text{ В}$ мкВ	504УН1	3	-
	504УН2	5	-
Максимальная амплитуда выходного напряжения, при $f = 1 \text{ кГц}$, $R_H = 3 \text{ кОм}$, $U_{вх}$ $K_T U_{вх} < 10\%$, $K_T U_{вх} < 1\%$, $U_{н.п.} = -12 \text{ В}$ мВ	504УН1	-	0,5
	504УН2	-	-

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДОПУСТИМЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наименование параметра	Тип микросхемы	Норма	
		не менее	не более
Входное напряжение, $U_{вх, max}$ В	504УН1, 504УН2	-	-0,3+2
Напряжение питания, $U_{н.п., max}$ В	504УН1, 504УН2	-	-13,2
Активная нагрузка, $R_{н min}$ кОм	504УН1, 504УН2	30	
Реактивная нагрузка, $Z_{н min}$ кОм	504УН1, 504УН2	3	
Диапазон рабочих температур, t °C	504УН1, 504УН2	-	-60+125

Содержание драгоценных металлов в одной микросхеме

Место для штампа
"Золото" мг

26,8881 мг - 3 л. 999

Микросхема 504 УН25 соответствует техническим условиям 0.348.003 ТУ и признана годными для эксплуатации.

Дата выпуска

- * ДЕК 1977

Место для штампа
ОТК



Место для штампа
представителя заказчика

Технические условия 0.348.003 ТУ.

